

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2004年12月23日 (23.12.2004)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2004/112142 A1

(51)国際特許分類⁷: H01L 27/092, H03G 11/00, H03K 5/00, H01L 29/78, 21/336

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/008219

(22)国際出願日: 2004年6月11日 (11.06.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:
特願2003-170105 2003年6月13日 (13.06.2003) JP

(71)出願人および
(72)発明者: 大見忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒9800813 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2-1-17-301 Miyagi (JP).

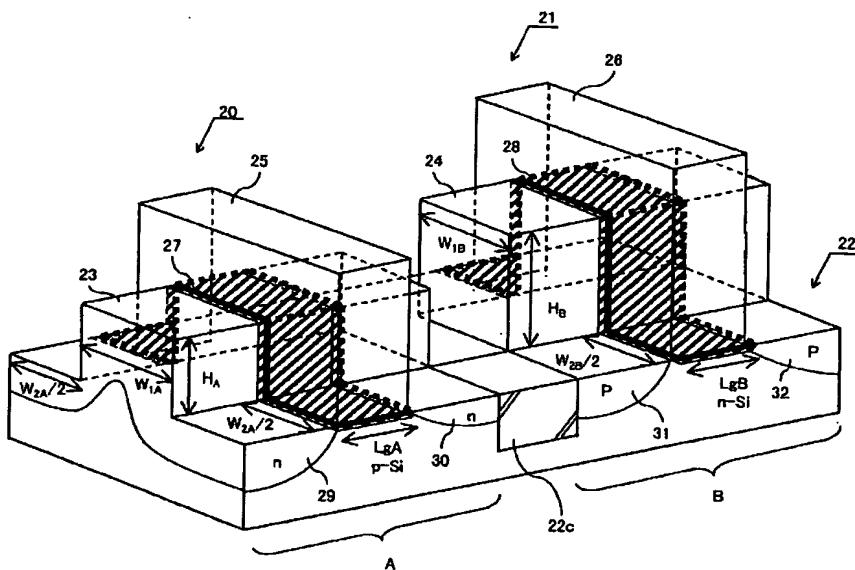
(72)発明者; および
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 西牟田武史 (NISHIMUTA, Takefumi) [JP/JP]; 〒4488671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織機内 Aichi (JP). 宮城弘 (MIYAGI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒9430834 新潟県上越市西城町2丁目5番13号 新潟精密株式会社内 Niigata (JP). 須川成利 (SUGAWA, Shigetoshi) [JP/JP]; 〒9800861 宮城県仙台市青葉区川内元支倉35-2-102 Miyagi (JP). 寺本章伸 (TERAMOTO, Akinobu) [JP/JP]; 〒9830037 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目1-22-K6 Miyagi (JP).

(74)代理人: 大音義之 (OSUGA, Yoshiyuki); 〒1020084 東京都千代田区二番町8番地20二番町ビル3F Tokyo (JP).

/締葉有/

(54) Title: LIMITER CIRCUIT AND SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT THEREOF

(54)発明の名称: リミッタ回路及びその半導体集積回路



(57) Abstract: A rectangular parallelepiped protrusion part (21) having a height H_B and a width W_B is formed on a silicon substrate, and a gate oxide film is formed on portions of the top and side wall surfaces of the protrusion part (21). A source and a drain are formed on the two opposite sides of a gate electrode (26), thereby forming a MOS transistor. A differential amplifier circuit comprising MOS transistors (61, 62) is used to configure a limiter circuit. In this way, the limiter circuit can exhibit a greater gain.

/締葉有/

WO 2004/112142 A1



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: シリコン基板上に高さ H_B で、幅が W_B の直方体状の突出部 21 を形成し、突出部 21 の頂面及び側壁面の一部にゲート酸化膜を形成する。ゲート電極 26 の両側にソースとドレインを形成してMOSトランジスタを形成する。MOSトランジスタ 61 と 62 とからなる差動增幅回路でリミッタ回路を構成する。これにより、リミッタ回路の利得を大きくとれるようとする。